

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCI)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
28 octobre 2004 (28.10.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/091767 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ : B01J 2/00,
B22F 3/12, C30B 15/02, 29/06

(21) Numéro de la demande internationale :
PCI/FR2004/050152

(22) Date de dépôt international : 9 avril 2004 (09.04.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
03/04675 14 avril 2003 (14.04.2003) FR

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) :
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR/FR]; 3, Rue Michel Ange, F-75794
PARIS CEDEX 16 (FR). UNIVERSITÉ DE POITIERS [FR/FR]; 15, Rue de l'Hôtel Dieu, F-86034 POITIERS
CEDEX (FR)

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : SIRABONI,
Alain [FR/FR]; 6, Rue Marcel Pagnol, F-86180 BUXE-
ROLLES (FR)

(74) Mandataire : CABINET MICHEL DE BEAUMONT,
Michel; 1, rue Champollion, F-38000 GRENOBLE (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM,
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, IR),
OAPI (BF, BI, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, IG).

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des
revendications sera republiée si des modifications sont re-

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-
tions se référer aux Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR GRANULES

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION DE GRANULES SEMICONDUCTEURS

(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of semiconductor granules, comprising a step in which semi-
conductor powders are sintered and/or melted. The powders are nanometric and/or micrometric sized

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication de granules semiconducteurs comportant une étape de frittage et/ou
de fusion de poudres semiconductrices. Les poudres comprennent des poudres de taille nanométrique et/ou micrométrique.

WO 2004/091767 A1